

04; 10

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НЕУСТОЙЧИВОСТИ  
ПОПЕРЕЧНО ОГРАНИЧЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА  
В ЗАМАГНИЧЕННОЙ ПЛАЗМЕ

Н.И. Карбушев

1. В работе [1] было показано, что характер неустойчивости тонкого ленточного электронного пучка в изотропной горячей плазме отличается от характера плазменно-пучковой неустойчивости в пространственно безграничной системе [2, 3]. В настоящей работе исследуется неустойчивость ленточного электронного пучка в холодной замагниченной плазме. Показывается, что максимальный инкремент неустойчивости при достаточно малой толщине пучка имеет зависимость от его ленгмюровской частоты, качественно отличную от известных в литературе зависимостей. Развитие такой неустойчивости сопровождается излучением плазменных волн в поперечном направлении, находящихся в черенковском резонансе с пучком.

2. Рассмотрим ленточный моноэнергетичный электронный пучок бесконечной ширины, однородный в слое  $|x| < \alpha$ , распространяющийся в пространственно безграничной холодной замагниченной однородной плазме. Скорость пучка  $u$  направлена вдоль оси координат  $Z$ , плотности электронов пучка и плазмы равны соответственно  $n_b$  и  $n_p$ .

Составляющая электрического поля  $E_Z$  монохроматической волны на частоте  $\omega$  с волновым вектором  $k$  ( $E_Z \sim \exp(-i\omega t + ikz)$ ) подчиняется уравнению

$$\frac{\partial^2 E_Z}{\partial x^2} - \kappa^2 \left[ 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} - \frac{\omega_b^2(x)}{\gamma^3(\omega - ku)^2} \right] E_Z = 0, \quad (1)$$

где  $\omega_{p,b} = (4\pi e^2 n_{p,b}/m)^{1/2}$ ,  $\kappa^2 = k^2 - \omega^2/c^2$ ,  $\gamma = (1 - u^2/c^2)^{-1/2}$ ,  $e$  и  $m$  - заряд и масса электрона,  $c$  - скорость света. Его решение можно представить в виде

$$E_Z(x) = \begin{cases} E_1 \cos(\kappa x \sqrt{-\varepsilon}), & |x| < \alpha, \\ E_2 \exp(i\kappa |x| \sqrt{-\varepsilon_p}), & |x| > \alpha, \end{cases} \quad (2)$$

где  $\varepsilon = \varepsilon_p - \omega_b^2/\gamma^3(\omega - ku)^2$ ,  $\varepsilon_p = 1 - \omega_p^2/\omega^2$ . Использование условий непрерывности  $E_Z$  и ее производной по  $x$  на границах пучка  $|x| = \alpha$  приводит к дисперсионному уравнению

$$\sqrt{-\varepsilon} \operatorname{tg}(\kappa \alpha \sqrt{-\varepsilon}) = -i\sqrt{-\varepsilon_p}. \quad (3)$$

Решение (2) на бесконечном удалении от пучка  $|x| \rightarrow \infty$  должно удовлетворять условиям ограниченности амплитуды поля

по величине и излучения волн в направлении от пучка, записываемым следующим образом:

$$\operatorname{Im}(\alpha\sqrt{-\epsilon_p}) > 0, \quad \operatorname{Re}(\alpha^*\sqrt{-\epsilon_p}) < 0. \quad (4)$$

3. При большой толщине электронного пучка, когда  $|\alpha\alpha\sqrt{-\epsilon_p}| \gg 1$ , из уравнения (3) следует известные выражения для инкрементов резонансной ( $\operatorname{Im}\omega \sim \omega_B^2/3$ ) и нерезонансной ( $\operatorname{Im}\omega \sim \omega_B$ ) плазменно-пучковых неустойчивостей [2, 3]. Наличие боковых границ пучка в этом случае практической роли не играет.

В случае малой толщины пучка, удовлетворяющей неравенству

$$|\alpha\alpha\sqrt{-\epsilon_p}| \ll 1, \quad (5)$$

дисперсионное уравнение (3) приводится к виду

$$\frac{\omega_B^2 \alpha}{\gamma^3 (\omega - k u)^2} \sqrt{k^2 - \frac{\omega^2}{c^2}} = i \sqrt{\frac{\omega^2}{\omega_p^2} - 1} \quad (6)$$

Отсюда находим, что инкремент нерезонансной неустойчивости ( $|\delta|/k u \ll |1 - k^2 u^2/\omega_p^2|$ ,  $\alpha = -k/\gamma < 0$ ) отличен от нуля в области  $k u < \omega_p$  и определяется выражением

$$\delta = \omega - k u = \frac{i-1}{\sqrt{2}} \frac{\omega_B}{\gamma^2} \frac{k \sqrt{\alpha} u}{(\omega_p^2 - k^2 u^2)^{1/4}}. \quad (7)$$

Инкремент максимален в точке  $k u = \omega_p$ , когда имеет место резонансная неустойчивость, а из дисперсионного уравнения (6) следует существование пяти нормальных волн, определяемых соотношением

$$(\sqrt{-\delta})^5 = -i \omega_p^{3/2} \omega_B^2 \alpha / \sqrt{2} \gamma^4 u. \quad (8)$$

Из них условиям (4) удовлетворяет только одна, для которой

$$\delta = (\omega_p^3 \omega_B^4 \alpha^2 / 2 \gamma^8 u^2)^{1/5} \exp(4\pi i/5). \quad (9)$$

В соответствии с неравенством (5) выражение (9) для инкремента резонансной неустойчивости имеет место в случае

$$(4 \omega_p^4 \omega_B^2 \alpha^5 / \gamma^9 u^5)^{1/5} \ll 1. \quad (10)$$

В противоположном пределе неустойчивость носит известный характер.

4. Инкремент (9) имеет зависимость от ленгмюровской частоты пучка ( $\sim \omega_B^{4/5}$ ), качественно отличную от известной [2, 3]. Развитие неустойчивости сопровождается излучением плазменных волн в поперечном направлении, фазовая скорость которых отличается от скорости пучка на малую величину  $\operatorname{Re}(\delta/k) < 0$ . При этом  $\operatorname{Re}(\alpha\sqrt{-\epsilon_p}) \ll k$ . Отношение плотностей потоков энергии этих волн в поперечном и продольном направлениях равно

$$\frac{S_{\text{эв}}}{S_{\text{з}}} = -\kappa \frac{\text{Re}(\alpha \epsilon^* \sqrt{-\epsilon_{\rho}})}{\omega_{\rho} |\epsilon_{\rho}|} = \sqrt{\frac{\omega_{\rho}}{2|\delta|\gamma^2}} \cos \frac{\pi}{10} \gg 1. \quad (11)$$

5. Решение (9) справедливо в приближениях  $|\delta| \ll \omega_{\rho}$  и  $|\delta| \ll \ll \omega_{\rho}/2(\gamma^2 - 1)$ . В случае ультрарелятивистских электронных пучков с  $\gamma^2 \gg 1$  второе из этих приближений может нарушаться при сохранении первого в силе. Если выполняется условие, противоположное второму, то инкремент нерезонансной неустойчивости, развивающейся в области  $k\kappa < \omega_{\rho}$ , определяется соотношением

$$\delta = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{(\omega_{\rho}^2 - k^2\kappa^2)^{1/3}} \frac{k\kappa}{\gamma^2} \left(\frac{\omega_{\rho}^2 \alpha}{2c}\right)^{2/3} \quad (12)$$

а для резонансной неустойчивости (в точке  $k\kappa = \omega_{\rho}$ ) имеет

$$\delta = \frac{i-1}{\sqrt{2}} \frac{\omega_{\rho}}{\gamma} \sqrt{\frac{\omega_{\rho} \alpha}{\gamma c}}. \quad (13)$$

Отношение плотностей потоков электромагнитной энергии излучаемых плазменных волн в поперечном и продольном направлениях в таком случае оказывается порядка единицы.

6. Обнаруженные особенности дают основание говорить о существовании плазменно-пучковых неустойчивостей нового типа с качественно отличными от известных характеристиками. Отметим, что аналогичное (7) выражение для инкремента нерезонансной неустойчивости было найдено в работе [1]. В резонансном же случае из результатов этой работы может быть получено выражение для максимального инкремента с зависимостью от ленгмюровской частоты пучка типа (9) ( $\text{Im}\omega \sim \omega_{\rho}^{4/5}$ ). Такая же зависимость максимального инкремента от ленгмюровской частоты электронного пучка была найдена ранее и в лазерах на свободных электронах [4].

Полученные в настоящей работе результаты остаются справедливыми при наличии удаленных от пучка металлических стенок, а также и в цилиндрической геометрии, если характерные поперечные размеры превышают величину  $[\text{Im}(\alpha \sqrt{-\epsilon_{\rho}})]^{-1}$ .

Автор выражает благодарность А.Д. Шаткусу за обсуждение результатов и полезные замечания.

#### С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Кондратенко А.Н. // Письма в ЖТФ. 1987. Т. 13. № 23. С. 1462-1464.
- [2] Ахизер А.И., Файнберг Я.Б. // ДАН СССР. 1949. Т. 69. № 4. С. 555-558.
- [3] Bohm D., Gross E. // Phys. Rev. 1949. V. 75. N 12. P. 1864-1876.
- [4] Гинзбург Н.С., Ковалев Н.Ф. // Письма в ЖТФ. 1987. Т. 13. № 5. С. 274-277.

Поступило в Редакцию  
14 июля 1989 г.